关于海森堡反铁磁链材料 LiVGe₂O₆ 有限温度 相变的理论研究^{*}

黄海 李伟锋†

(华北电力大学数理学院,北京 102206) (2013 年 6 月 28 日收到; 2013 年 8 月 7 日收到修改稿)

自旋 s = 1 的海森堡反铁磁链材料 LiVGe₂O₆ 的磁化率以及核磁共振实验表明该材料在临界温度约为 22 K 时 由顺磁相转变为反铁磁 Néel 相,且低温磁激发谱存在能隙.本文在己有模型哈密顿量的基础上提出了一个低能场论 模型——Ginzburg-Landau 理论来描述这一反铁磁链材料,并运用这一理论讨论了 LiVGe₂O₆ 由于自发对称性破缺导 致的有限温度相变及相应的磁化率变化情况,理论计算很好地解释了现有的实验结果.

关键词:海森堡模型, O(3) 非线性 σ 模型, 有限温度相变
PACS: 75.10.Pq
DOI: 10.7498/aps.62.217501

1引言

1983年, Haldane 预言整数自旋的海森堡反铁 磁链体系的第一激发态与基态之间存在能隙,而 半整数自旋的海森堡反铁磁链的磁激发谱由于拓 扑项的存在导致能隙消失 [1,2]. 此后, 整数自旋的 海森堡反铁磁链系统逐渐成为凝聚态物理的研究 热点. 实验上,Haldane 所预言的能隙已在多种自旋 s=1的反铁磁链材料中被观测到,例如CsNiCl₃^[3], NENP^[4,5], AgVP₂S₆^[6] 以及 Y₂BaNiO₅^[7,8]. 最近, s = 1的反铁磁链材料 LiVGe₂O₆ 表现出一些特 殊的性质,引起了人们的极大兴趣. LiVGe₂O₆ 属 于碱金属辉石族化合物. X 射线衍射实验表明 LiVGe2O6 属于单斜晶系,空间群为 P21/c. 晶格参 数 a = 9.863 Å, b = 8.763 Å以及 c = 5.409 Å^[9,10]. 从 Li+, Si⁴⁺ 和 O²⁻ 的最常见氧化态考虑, V 离子显示 +3 价. V 的外层电子排布为 3d³4s². 除去被氧化的 三个电子, 根据洪特定则, V³⁺ 的 3d 壳层的两个电 子的总自旋 s = 1. 在 LiVGe₂O₆中,正八面体原子 团 VO₆ 通过共边键接形成链状结构,而相邻链之间则通过正四面体原子团 GeO₄ 共点键接,因此链间相互作用相对链内相互作用来说很小,两者之比约为 0.03^[11,12].

LiVGe₂O₆ 粉末的磁化率测量结果显示,磁化 强度经过转变温度约 22 K 后迅速下降,且在低 温下磁激发谱存在能隙^[9]. Millet 等人建议, 材料 LiVGe₂O₆中可能存在异常大的四次交换相互作用 导致磁激发谱的 Haldane 能隙消失, 然后这个无能 隙的整数自旋链体系在温度为 22 K 时通过二聚作 用产生自旋 Peierls 相变^[9]. 自旋 Peierls 相变的发 生与系统晶格畸变紧密相关,近年来反铁磁链材料 中的自旋 Peierls 相变日益受到人们的重视 [13-15]. 但是最近⁷Li 核磁共振 (NMR) 实验结果表明, 所观 察到的相变不是自旋 Peierls 相变, 且得到的低温相 是反铁磁相^[16]. 在转变温度附近的中子衍射以及 X 射线衍射实验也表明在转变温度以下 LiVGe₂O₆ 确实具有反铁磁长程序,且没有证据表明相变伴随 着结构畸变^[11].为了解释 LiVGe₂O₆ 的这些奇特性 质, Vonlanthen 等人提出了一个新的理论模型^[17].

^{*} 中央高校基本科研业务费专项基金 (批准号: 12ZP11,13TD03) 资助的课题.

[†]通讯作者. E-mail: lwf19870715@163.com

系统的哈密顿量为

$$H = J \sum_{i} S_{i} \cdot S_{i+1} + J' \sum_{\langle i,j \rangle} S_{i} \cdot S_{j} - E_{z} \sum_{i} S_{i,z}^{2}, \quad (1)$$

其中 J和 J'分别代表链内和链间交换能的耦合常数. 对于 LiVGe₂O₆,我们有 $J \approx 45$ K和 $J' \approx 1.4$ K. 由于 $J' \approx 0.03J$,我们将在以下分析中略去链间耦合的影响. E_z 为伊辛项系数且 $E_z > 0$.我们将基于系统哈密顿量(1)式提出描述 LiVGe₂O₆的低能场论模型——Ginzburg-Landau (GL)理论. 然后我们从 GL 理论出发,研究这一材料由于自发对称性破缺导致的有限温度相变问题. 理论计算表明,LiVGe₂O₆在22 K 左右发生一级相变,体系从顺磁相转变为反铁磁 Néel 相且在低温下磁激发谱存在约 15 K 的能隙.我们根据得到的 LiVGe₂O₆的有限温度能隙计算了这一材料的磁化率,结果与实验事实相符.

2 低能场论模型

系统哈密顿量 (1) 式中的第一项为反铁磁海森 堡模型. 对于反铁磁链材料,由于 J > 0,故在经典 情形下相邻格点自旋取向相反时能量最低. 虽然由 于量子扰动的影响,反铁磁 Néel 态不再是海森堡 模型的基态,但在 4—5 个格点范围内,相邻格点间 自旋仍呈一定的反铁磁相关 ^[18,19].由此我们可以 把每个格点的自旋算符写为 $S_i = (-1)^i s \varphi_i + l_i$. 其 中 φ_i 为局域 Néel 序参量, l_i 代表平均磁化密度.由 于 φ_i 和 l_i 为缓变函数,在低能近似下我们可以把 这两个量进行连续化,并且反铁磁海森堡模型可以 用一个量子场论模型——O(3) 非线性 σ 模型来描述 ^[1,2,18].相应的哈密顿量为

$$H = \frac{v}{2} \int \mathrm{d}x \left[g l^2 + \frac{v}{g} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^2 \right], \qquad (2)$$

其中 g = 2/s, v 为自旋波速, 密度矩阵重整化群计 算给出 $v \approx 2.5J^{[20,21]}$. 我们设 x 轴为链方向, 且 $\varphi(x)$ 场满足约束条件 $\varphi^2 = 1$. 由于自旋算符满足 SU(2)代数, 算符 l 可写为

$$l = \frac{1}{vg} \varphi \times \frac{\partial \varphi}{\partial t}.$$
 (3)

相应的拉格朗日量为

$$L = \frac{g}{2} \left[\frac{1}{v} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} \right)^2 - v \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^2 \right].$$
(4)

由于约束 $\varphi^2 = 1$ 的存在, O(3) 非线性 σ 模型是一个 相当复杂的非线性理论. 该理论存在一个守恒的旋 转对称性, 与之相对应的守恒自旋算符为 $S = \int dxl$, 因此在 O(3) 非线性 σ 模型中 l 代表守恒自旋密度. 关于 O(3) 非线性 σ 模型的理论分析表明, 该模型 有一个唯一的自旋为零的基态, 最低激发态为自 旋为 1 的三重态, 且基态与最低激发态之间存在 Haldane 能隙 $\Delta \approx 0.41J^{[21-24]}$. 该理论没有束缚态 解, 描述低能激发的准粒子之间为排斥相互作用.

事实上,我们可以通过重整化群分析将 O(3) 非 线性 σ 模型映射到一个相对简单的理论 ——GL 理 论,这一理论保留了 O(3) 非线性 σ 模型的上述所 有特征 ^[25,26]. 在 GL 理论中,约束 $\varphi^2 = 1$ 不复存在, 拉格朗日量代之以

$$L = \frac{1}{2\nu} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t}\right)^2 - \frac{\nu}{2} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2 - \frac{\Delta^2}{2\nu} \varphi^2 - \lambda \varphi^4, \quad (5)$$

 λ 表征激发态准粒子之间的排斥相互作用强度.此时,平均磁化密度算符可表为 $l = (1/v)\varphi \times (\partial \varphi/\partial t)$.

在系统哈密顿量 (1) 式中,除了反铁磁海森堡 模型以外,我们还需考虑伊辛项 $-E_z S_z^2$ 的影响.由 于 φ_z 和 l_z 的交叉项对 x 轴求和后的总贡献为零,且 l_z^2 项在重整化群变换下是非关涉算符.故在考虑伊 辛项后,我们只需在拉格朗日量 (5) 式中添加 $E_z \varphi_z^2$, 相应的拉格朗日量改为

$$L = \frac{1}{2v} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t}\right)^2 - \frac{v}{2} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2 - \frac{\Delta_x^2}{2v} \varphi_x^2 - \frac{\Delta_y^2}{2v} \varphi_y^2 - \frac{\Delta_z^2}{2v} \varphi_z^2 - \lambda \varphi^4, \qquad (6)$$

其中 $\Delta_x = \Delta_y = \Delta$ 及 $\Delta_z^2 = \Delta^2 - 2\nu E_z$.

在一维量子体系中, 伴随产生的 Goldstone 粒 子的红外发散会破坏连续对称性的自发破缺, 从而 导致长程序的消失^[27].因此, 如果不考虑链间耦 合, 具有 *SU*(2) 或 *U*(1)(在引入晶体场各向异性项 后) 连续对称性的一维链海森堡模型是不会产生自 发对称性破缺的. 但在我们讨论的 (6) 式中, 如果 $\Delta_z^2 < 0$, 系统基态破坏的是分立而非连续的 *Z*₂ 对 称性 ($\varphi_z \rightarrow -\varphi_z$). 这一对称性的自发破缺不伴随产 生无质量的 Goldstone 粒子, 因此我们讨论的一维 模型在低温下能够实现自发对称性破缺, 从而导致 链内 Néel 序参量不为零. 同时由于链间反铁磁耦 合的作用,材料 LiVGe₂O₆的基态为三维的反铁磁 Néel态.随着温度的逐渐升高,体系将发生从反铁 磁态到顺磁态的有限温度相变.(6)式即为描述海 森堡反铁磁链材料 LiVGe₂O₆ 的低能场论模型.

3 有限温度相变研究

由 (6) 式的拉格朗日量, 我们可以得到相应的 势能函数为

$$V(\varphi) = \frac{1}{2\nu} \Delta_x^2 \varphi_x^2 + \frac{1}{2\nu} \Delta_y^2 \varphi_y^2 + \frac{1}{2\nu} \Delta_z^2 \varphi_z^2 + \lambda \varphi^4.$$
(7)

对于量子场 φ_x 和 φ_y 而言,因为 $\Delta^2 > 0$,势能极小值 点出现在 $\varphi_x = \varphi_y = 0$ 处.而对于 φ_z 场,如果 $\Delta_z^2 < 0$, 势能极小值点出现在 $\varphi_0 = \sqrt{-\Delta_z^2/4\lambda v}$ 处,在低温 下 ϕ_z 场会发生自发对称性破缺.此时由于 Néel 序 参量 $\varphi_0 \neq 0$,系统处于反铁磁相.将势能函数 $V(\varphi)$ 在 $\varphi_z = \varphi_0$ 附近展开,容易得到 φ_x 和 φ_y 场的准粒 子质量为 $\overline{\Delta}_x = \overline{\Delta}_y = \sqrt{\Delta^2 - \Delta_z^2}$,而 φ_z 场的准粒子质 量为 $\overline{\Delta}_z = \sqrt{-2\Delta_z^2}$.



图 1 (a) 费曼规则; (b) 自能修正费曼图 (i, j = x, y, z)

现在我们开始计算 φ 场在有限温度下的自能 修正.在零温下,对于一维量子场的圈图积分可以 通过对场算符做正规乘积消去^[28].但是在有限温 度下,我们必须保留这些圈图贡献.拉格朗日量(6) 式所对应的费曼规则见图 1(a).精确到 λ 的一次方, 我们可以得到图 1(b) 中所示的自能修正费曼图.

具体的自能计算结果为

$$\Pi_{i} = \sum_{j=x,y,z} \left[4(1+2\delta_{ij})\lambda vT \times \sum_{n} \int \frac{v dk}{2\pi} \frac{1}{\omega_{n}^{2} + \omega_{jk}^{2}} \right], \quad (8)$$

其中 $\omega_{jk} = \sqrt{\overline{\Delta}_j^2 + v^2 k^2}$ 及 $\omega_n = 2\pi n/T$ ($n \in Z$). 我 们可以通过标准的围道积分方法计算 (8) 式中的级 数求和,结果可得

$$\Pi_i = \Pi_i^{\text{vac}} + \Pi_i^{\text{ther}},\tag{9}$$

其中

$$\Pi_{i}^{\text{vac}} = \sum_{j=x,y,z} \left[4(1+2\delta_{ij})\lambda \nu \int \frac{\nu dk}{2\pi} \frac{1}{2\omega_{jk}} \right], \quad (10)$$

$$\Pi_{i}^{\text{ther}} = \sum_{j=x,y,z} \left[4(1+2\delta_{ij})\lambda v \right] \times \int \frac{v dk}{2\pi} \frac{1}{\omega_{jk} \left(e^{\omega_{jk}/T} - 1\right)} \left].$$
(11)

自能的真空贡献 Π_i^{vac} 是对数发散的, 它的作用是 对 φ 场的裸质量进行重整化. 而 Π_i^{ther} 则是对物理 质量的有限温度修正, 故在有限温度下 φ 场的有效 势能函数可表为

$$V_{\text{eff}}(\varphi) = \frac{1}{2\nu} \Delta_x^2(T) \varphi_x^2 + \frac{1}{2\nu} \Delta_y^2(T) \varphi_y^2 + \frac{1}{2\nu} \Delta_z^2(T) \varphi_z^2 + \lambda \varphi^4, \quad (12)$$

其中 $\Delta_i^2(T) = \Delta_i^2 + \Pi_i^{\text{ther}}$. 在低温下由于 $\Delta_z^2(T) < 0$, φ_z 场发生自发对称性破缺,有效势的极小值处 于 $\varphi_0(T) = \sqrt{-\Delta_z^2(T)/4\lambda v}$. 将势能函数 $V_{\text{eff}}(\varphi)$ 在 $\varphi_z = \varphi_0(T)$ 附近展开,可得 φ_x 和 φ_y 场的准粒子有 效质量为 $\bar{\Delta}_x = \bar{\Delta}_y = \sqrt{\Delta_x^2(T) - \Delta_z^2(T)}$,以及 φ_z 场的 有效质量为 $\bar{\Delta}_z(T) = \sqrt{-2\Delta_z^2(T)}$. 当温度大于临界 温度 T_c 时,由 (12) 式显见 φ_x 和 φ_y 场的有效质量为 $\bar{\Delta}_x = \bar{\Delta}_y = \Delta_x(T)$, φ_z 场的有效质量为 $\bar{\Delta}_z(T) = \Delta_z(T)$.

我们取 $E_z = 2.0$ K 和 $\lambda = 0.16$ K, φ 场有效质 量的数值计算结果如图 2 实线所示. 从图中可以看 出, φ 场在低温反铁磁相仍存在能隙. 在零温附近, 有 $\bar{\Delta}_x = \bar{\Delta}_y \approx 21$ K 及 $\bar{\Delta}_z \approx 15$ K, 其中低能模 φ_z 的 有效质量与实验测得的低温能隙对应且两者相符 ^[10]. 随着温度的逐渐升高, φ 场的能隙逐渐减小, 在 临界温度 $T_c = 22$ K 时 φ_z 场的准粒子有效质量降为 零, 即体系在 T_c 处发生了二级相变. 在临界温度 T_c 以上, φ 场的能隙随着温度的升高而增大. 在温度



217501-3

T = 50 K 时, 我们有 $\overline{\Delta}_x = \overline{\Delta}_y \approx 25$ K 和 $\overline{\Delta}_z \approx 16$ K.

需要指出的是,如果考虑单圈的辐射场修 正,在一维情形下有效势(12)式应添加项 – $[(\Delta_x^2 + 4\lambda v \varphi_z^2)/4\pi] \ln [(\Delta_x^2 + 4\lambda v \varphi_z^2)/\mu^2]^{[29]}$.其中 μ 为 重整化后的物理参量所对应的能阶,在本文中可取 $\mu \approx 10$ K. 经具体计算, φ_x 和 φ_y 场的准粒子有效质 量与修正前相比基本不变,而修正后的 ϕ_z 场的有效 质量如图 2 虚线所示.最大的不同是,在临界温度 T_c 即三角形标注处, φ_z 场的有效质量仍为非零值, 约为 1.5 K. 这预示着在考虑辐射场的量子修正后, 系统由二级相变转化为一级相变.

4 有限温度磁化率的计算

现在我们来计算 LiVGe₂O₆ 在有限温度下的 磁化率. 在外加磁场中, 相应的哈密顿量应添加 $g_L\mu_Bh\cdot S$, 在 GL 理论中此项可表为 $\int dxg_L\mu_Bh\cdot l$. 其中 h 代表外加磁场, g_L 表示朗德因子且有 $g_L \approx 1.79^{[9]}$.

由磁化率的定义,我们可以得到零场下沿三个 轴向的磁化率分别为^[26,30]

$$\chi_z(T) = \frac{1}{Z} \frac{\left(g_{\rm L} \mu_{\rm B}\right)^2}{T} \sum_{a,b} \left| \langle a | S_z | b \rangle \right|^2 e^{-E_a/T} \qquad (13)$$

和

$$\chi_{x}(T) = \chi_{y}(T) = \frac{1}{Z} (g_{\rm L} \mu_{\rm B})^{2} \\ \times \sum_{a,b} |\langle a | S_{x} | b \rangle|^{2} \frac{(e^{-E_{\rm b}/T} - e^{-E_{\rm a}/T})}{E_{\rm a} - E_{\rm b}}, \quad (14)$$

式中对 a, b 的求和符号是对所有的粒子态求和, Z 表示系统相应的配分函数.

我们可以用湮灭产生算子 *a_{ik}* 和 *a⁺_{ik}* 对量子场 *φ* 进行傅里叶展开:

$$\varphi_{i}(x,t) = \sum_{k} \sqrt{\left(\frac{v}{2L\bar{\omega}_{ik}}\right)} \times \left[e^{-i(\bar{\omega}_{ik}t - kx)}a_{ik} + \text{H.c.}\right], \quad (15)$$

式中 *L* 表示自旋链长度.此时,在不考虑外磁场且精确到 φ 场的二次方项,哈密顿量可写为 $H = \sum_{i,k} \bar{\omega}_{ik} (a_{ik}^{\dagger} a_{ik} + 1/2).$ 由(15)式,我们可以算得 沿各轴向的平均磁化强度为

$$\int \mathrm{d}x l_z = i \sum_k \left(a_{xk}^{\dagger} a_{yk} - a_{yk}^{\dagger} a_{xk} \right) \tag{16}$$

以及

$$\int \mathrm{d}x l_x = \frac{\mathrm{i}}{2} \sum_k \left[\left(\sqrt{\frac{\bar{\omega}_{yk}}{\bar{\omega}_{zk}}} + \sqrt{\frac{\bar{\omega}_{zk}}{\bar{\omega}_{yk}}} \right) \left(a_{yk}^{\dagger} a_{zk} - a_{zk}^{\dagger} a_{yk} \right) + \left(\sqrt{\frac{\bar{\omega}_{yk}}{\bar{\omega}_{zk}}} - \sqrt{\frac{\bar{\omega}_{zk}}{\bar{\omega}_{yk}}} \right) \left(a_{yk}^{\dagger} a_{z,-k} - a_{yk}^{\dagger} a_{z,-k} \right) \right].$$
(17)

然后将 (16) 和 (17) 式分别代入 (13) 和 (14) 式, 用 ∫ dxl 代替总自旋算符 S 并对 k 进行连续化, 我 们得出磁化率的平均场结果为^[26]

$$\chi_z(T) = \frac{2}{T} \left(g_{\rm L} \mu_{\rm B} \right)^2 \int \mathrm{d}k \frac{n_{xk} \left(n_{xk} + 1 \right)}{2\pi} \tag{18}$$

和

$$\chi_{x}(T) = (g_{\mathrm{L}}\mu_{\mathrm{B}})^{2} \int \mathrm{d}k \left[\frac{\left(1 + n_{yk} + n_{zk}\right) \left(\bar{\omega}_{yk} - \bar{\omega}_{zk}\right)^{2}}{\left(\bar{\omega}_{yk} + \bar{\omega}_{zk}\right)} + \frac{\left(n_{yk} - n_{zk}\right) \left(\bar{\omega}_{yk} + \bar{\omega}_{zk}\right)^{2}}{\left(\bar{\omega}_{zk} - \bar{\omega}_{yk}\right)} \right] \times \left(\frac{1}{4\pi\bar{\omega}_{yk}\bar{\omega}_{zk}}\right),$$
(19)

式中 n_{ik} 代表波色子占有数 $n_{ik} = 1/(e^{-\omega_{ik}/T} - 1)$. 最后,我们对各个轴向的磁化率取平均,得出粉末 样品的有效磁化率^[10]

$$\chi(T) = \frac{1}{3}\chi_z(T) + \frac{2}{3}\chi_x(T).$$
 (20)

磁化率的数值计算结果如图 3 所示. 图中的 空心圆点是实验测得的磁化率,杂质的贡献已用 Curie-Weiss 形拟合低温磁化率加以扣除^[9,31]. 从图 中可以看出,在很宽的温度范围内,理论计算均与 实验结果符合得极好. 需要指出的是,为较好地拟 合磁化率实验数据,我们发现必须选取经过辐射场 修正的 φ 场有效质量,这说明体系在临界温度 22 K 发生的是量子扰动引发的一级相变.



217501-4

5 结 论

本文在己有模型哈密顿量的基础上提出了一 个低能场论模型——GL理论来描述自旋 s = 1 的海 森堡反铁磁链材料 LiVGe₂O₆. 然后,我们运用 GL

- [1] Haldane F D M 1983 Phys. Rev. Lett. 50 1153
- [2] Haldane F D M 1983 Phys. Lett. **93A** 464
- [3] Buyers W J L, Morra R M, Armstrong R L, Hogan M J, Gerlach P, Hirakawa K 1986 Phys. Rev. Lett. 56 371
- [4] Renard J P, Verdaguer M, Regnault L P, Erkelens W A C, Rossat-Mignod J, Stirling W G 1987 Europhys. Lett. 3 945
- [5] Lu W, Shen X, Liu P, von Ortenberg M, Tuchendler J, Renard J P, Zheng F 1995 Chin. Phys. Lett. 12 313
- [6] Mutka H, Soubeyroux J L, Bourleaux G, Colombet P 1989 *Phys. Rev.* B 39 4820
- [7] Xu G, DiTusa J F, Ito T, Oka K, Takagi H, Broholm C, Aeppli G 1996 Phys. Rev. B 54 R6827
- [8] Kong H Y, Zhang L, Song Y 2006 Acta Phys. Sin. 55 4865 (in Chinese) [孔红艳, 张林, 宋筠 2006 物理学报 55 4865]
- [9] Millet P, Mila F, Zhang F C, Mambrini M, Van Oosten A B, Pashchenko V A, Sulpice A, Stepanov A 1999 Phys. Rev. Lett. 83 4176
- [10] Pedrini B, Wessel S, Gavilano J L, Ott H R, Kazakov S M, Karpinski J 2007 Eur. Phys. J. B 55 219
- [11] Lumsden M D, Granroth G E, Mandrus D, Nagler S E, Thompson J R, Castellan J P, Gaulin B D 2000 Phys. Rev. B 62 R924
- [12] Scalapino D J, Imry Y, Pinkus P 1975 Phys. Rev. B 11 2042
- [13] Wang Z G, Ding G H, Xu B W 1999 Acta Phys. Sin. 48 296 (in Chinese) [王治国, 丁国辉, 许伯威 1999 物理学报 48 296]
- [14] Liu H L, Wang Z G, Yang C Q, Huang X S, Shi Y L 2007 Chin. Phys.

理论讨论了 LiVGe₂O₆ 由于自发对称性破缺导致的 有限温度相变及磁化率的变化情况,理论计算结果 与己有实验事实相符.此外,我们希望 LiVGe₂O₆ 的 能隙随温度变化曲线能够在这一材料的中子散射 实验中得到证实.

16 3858

- [15] Wang Q B, Xu X F, Tao Q, Wang H T, Xu Z A 2008 Chin. Phys. B 17 3490
- [16] Gavilano J L, Mushkolaj S, Ott H R, Millet P, Mila F 2000 Phys. Rev. Lett. 85 409
- [17] Vonlanthen P, Tanaka K B, Goto A, Clark W G, Millet P, Henry J Y, Gavilano J L, Ott H R, Mila F, Berthier C, Horvatic M, Tokunaga Y, Kuhns P, Reyes A P, Moulton W G 2002 *Phys. Rev.* B 65 214413
- [18] Affleck I 1989 J. Phys.: Condens. Matter 1 3047
- [19] Takahashi M 1989 Phys. Rev. Lett. 62 2313
- [20] Sorensen E S, Affleck I 1994 Phys. Rev. B 49 15771
- [21] Sorensen E S, Affleck I 1993 Phys. Rev. Lett. 71 1633
- [22] White S R 1992 Phys. Rev. Lett. 69 2863
- [23] White S R 1993 Phys. Rev. B 48 10345
- [24] White S R, Huse D A 1993 Phys. Rev. B 48 3844
- [25] Affleck I 1989 Phys. Rev. Lett. 62 474
- [26] Affleck I 1990 Phys. Rev. B 41 6697
- [27] Coleman S 1973 Commun. Math. Phys. 31 259
- [28] Coleman S 1975 Phys. Rev. D 11 2088
- [29] Huang K 1992 Quarks, Leptons and Gauge Fields (2nd Ed.) (Singapore: World Scientific) Chapter 10
- [30] Huang H, Affleck I 2004 Phys. Rev. B 69 184414
- [31] Lou J, Xiang T, Su Z 2000 Phys. Rev. Lett. 85 2380

Analysis of the finite-temperature phase transition of Heisenberg antiferromagnetic compound LiVGe₂O₆*

Huang Hai Li Wei-Feng[†]

(Mathematics and Physics Department, North China Electric Power University, Beijing 102206, China) (Received 28 June 2013; revised manuscript received 7 August 2013)

Abstract

The susceptibility and nuclear magnetic resonance measurements on quasi-one-dimensional spin-1 Heisenberg antiferromagnet $LiVGe_2O_6$ indicate that this material shows a phase transition from paramagnetic state to antiferromagnetic Néel state at about 22 K, and there exists a gap in the low-temperature magnetic excitation spectrum. Based on the model Hamiltonian of $LiVGe_2O_6$, we propose a low-energy field theory—Ginzburg-Landau theory for this compound. From this theory, we study the finite-temperature phase transition induced by spontaneous symmetry breaking and then calculate the finite-temperature susceptibility of $LiVGe_2O_6$. All the theoretical calculations are consistent with the experimental results.

Keywords: Heisenberg model, O(3) non-linear σ model, finite-temperature phase transition

PACS: 75.10.Pq

DOI: 10.7498/aps.62.217501

^{*} Project supported by the Fundamental Research Funds for the Central Universities of Ministry of Education of China (Grant Nos. 12ZP11, 13TD03).

[†] Corresponding author. E-mail: lwf19870715@163.com